

Атомные процессы на поверхности, границах раздела и в объеме кремния: дефекты, примесные атомы, тонкие пленки.

4-е заседание Председатель – Л.И. Федина

- 15³⁰ – 16⁰⁰ **Д.В. Щеглов**, Л.И. Федина, С.В. Ситников, Д.И. Роголо, Е.Е. Родякина, А.С. Кожухов, А.В. Латышев
От процессов самоорганизации на поверхности кремния к субнанометровой метрологии (**приглашенный доклад**).
ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия.
- 16⁰⁰ – 16³⁰ **О. Ф. Вывенко**¹, Д. В. Данилов¹, А.С. Лошаченко¹, Н.А. Маслова¹, Н.А. Соболев².
Электронные свойства кислородных преципитатов в кремнии (**приглашенный доклад**).
¹Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;
²ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия.
- 16³⁰ – 16⁵⁰ Кофе-брейк
- 16⁵⁰ – 17⁰⁵ **Д.Б. Богомолов**, М.О. Петрушков, Д.С. Абрамкин, Е.А. Емельянов, М.А. Путьято, А.К. Гутаковский, В.В. Преображенский.
Получение эпитаксиальных слоев GaP без антифазных доменов на подложках кремния.
ФГБУН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, Россия
- 17⁰⁵ – 17²⁰ **М.О. Петрушков**, Д.С. Абрамкин, М.А. Путьято, Е.А. Емельянов, А.В. Васев, А.К. Гутаковский, В.В. Преображенский.
Механизмы влияния слоев LT-GaAs на систему пронизывающих дислокаций в